

Patent number:

JP2002321084

Publication date:

2002-11-05

Inventor:

SUESHIGE YOSHITAKA; MORIMOTO KEI

Applicant:

SUMITOMO METAL MINING CO

Classification:

- international:

B23K35/26; C22C13/02

- european:

Application number: JP20010129194 20010426 Priority number(s): JP20010129194 20010426

Report a data error here

Abstract of JP2002321084

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a Sn-Sb based-soldering alloy for joining electronic parts, which substantially includes no Pb, and has a high solid phase melting point, and an improved wettability, heat resistance and thermal fatigue characteristic. SOLUTION: The alloy comprises Sb of 11-15 in mass %, at least one of either Ni or Ge of 0.01-1 in mass % and substantially the remainder of Sn.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

This Page Blank (uspto)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-321084 (P2002-321084A)

(43)公開日 平成14年11月5日(2002.11.5)

ZAB

(51) Int.Cl.7

識別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

B 2 3 K 35/26

C 2 2 C 13/02

3 1 0 ZAB B 2 3 K 35/26

310A

C 2 2 C 13/02

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2001-129194(P2001-129194)

平成13年4月26日(2001.4.26)

(71)出願人 000183303

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁目11番3号

(72)発明者 末繁 由隆

東京都肯梅市末広町1丁目6番1号 住友

金属鉱山株式会社電子事業本部内

(72)発明者 森本 圭

東京都骨梅市末広町1丁目6番1号 住友

金属鉱山株式会社電子事業本部内

(74)代理人 100084087

弁理士 鴨田 朝雄 (外1名)

(54) 【発明の名称】 電子部品接合用はんだ合金

(57)【要約】

【課題】 Pbを実質的に含まず、固相融点が高く、濡 れ性・耐熱性・熱疲労特性の改善された電子部品接合用 Sn-Sb系はんだ合金を提供する。

【解決手段】 Sbを11~15質量%、並びにNiお よびGeのうちの少なくとも1種を0.01~1質量% 含み、残部が実質的にSnからなる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 Sbを11~15質量%、並びにNiお よびGeのうちの少なくとも1種を0.01~1質量% 含み、残部が実質的にSnからなる電子部品接合用はん だ合金。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電子部品接合用は んだ合金に関し、さらに詳しくは鉛を実質的に含まない 電子部品接合用Sn-Sb系はんだ合金に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、電子部品接合用材料としてPbお よびSnを主成分としたはんだ合金が用いられてきた。 電子部品としてパワートランジスタを例に挙げると、パ ワートランジスタには大きな電流の負荷が加わるため、 パワートランジスタの接続に使用されるはんだ合金に は、応力緩和性、耐熱疲労特性、電気伝導性が要求され る。

【0003】パワートランジスタの接合の際、まず、パ ワートランジスタ内部においてリードフレームと半導体 20 チップを接合し(内部接合)、次に、パワートランジス タを基板に接合する(実装)。なお、パワートランジス タを基板に実装する際には、Snを63質量%含み、残 部がР b からなる共晶はんだ合金(融点183℃)を多 く用い、220~230℃でリフローを行う。

【0004】上記内部接合の工程で用いるはんだ合金の 固相融点が上記実装の工程で行うリフローの温度以下で あると、該リフローを行うときにパワートランジスタ内 部の該はんだ合金が再溶融するために、リードフレーム と半導体チップとの接合の信頼性が低下する。この再溶 30 融を防止するには、上記内部接合の工程において上記実 装時のリフロー温度以上の固相融点を有するはんだ合金 を使用する必要がある。そのため、Snを5質量%含 み、残部がPbからなるはんだ合金(固相融点305 ℃)や、Snを3質量%含み、残部がPbからなるはん だ合金(固相融点315℃)が多く用いられてきた。 【0005】以上のように、Pbを含むはんだ合金は電

【0006】しかしその一方で、このようなPbを含む 40 はんだ合金の有害性が指摘されだしている。すなわち、 廃棄処分された電子機器に上記Pbを含むはんだ合金が 使用されていると、該はんだ合金に含まれるPb成分が 酸性雨によって徐々に溶解流出し、土壌中に浸透し、農 作物などに蓄積し、ひいては人間に害を及ぼすというも のである。

子部品の接合用プロセスにおいて有効な材料として用い

られており、その信頼性も確立されてきた。

【0007】そこで、電子部品を基板に接合する工程で 用いられる上記共晶はんだ合金の代替品として、Snを 主成分としたはんだ合金が検討されている。このはんだ 合金は固相融点が上記共晶はんだ合金より上昇し、実装 50 が11質量%未満では、前述したように、固相融点が2

時のリフロー温度も250~260℃付近に上昇すると みられている。そのため、電子部品の内部に使用するは んだ合金は、このリフロー温度よりもさらに高い固相融 点を有することが要求される。

【0008】従来、Pbを実質的に含まない(Pbフリ ー)はんだ合金としてSn-Sb系はんだ合金が検討さ れている(以下、「Sn-Sb系」といえばPbを実質 的に含まない(Pbフリー)ことを意味する)。Sn-Sb系はんだ合金は、Sbが11質量%以上で固相融点 10 が246℃であって、Snを主成分としたはんだ合金で は実用可能な最高の固相融点を持つ。

[0000]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記S n-Sb系はんだ合金は、Sbの組成比率が11質量% を超えると、凝固する際に晶出する粗大な結晶粒を有す る組織となる。この結晶粒はSnとSbからなる金属間 化合物(Sn-Sb化合物)であり、硬くて脆い性質を 有するため、外部から負荷を与えると結晶粒の外郭(粒 界)に沿ってクラックが発生しやすくなる(耐熱性・熱 疲労特性の低下) という問題がある。このような問題に よる電子部品の信頼性の低下を避けるため、Sbの組成 比率が11質量%以下のはんだ合金が用いられてきた。 一方、Sbの組成比率が11質量%以下の上記Sn-S b系はんだ合金は、(1)固相融点が246°C以下とな るため、そして(2)基板実装用に前記共晶はんだ合金 (Pb-Sn系合金)の代替品であるSn-Sb系はん だ合金を用いた場合にリフロー温度を上げる必要がある ため、電子部品内部の接合性が損なわれる危険がある。 【0010】また、Sn-Sb系はんだ合金は、接合時 の濡れ性が乏しく、熱疲労特性も十分ではないという問 題があった。

【0011】本発明の目的は、上記問題を解消し、固相 融点が高く、濡れ性・耐熱性・熱疲労特性の改善された 電子部品接合用Sn-Sb系はんだ合金を提供すること にある。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するため、Sbを11~15質量%、並びにNiおよ びGeのうちの少なくとも1種を0.01~1質量%含 み、残部が実質的にSnからなる電子部品接合用はんだ 合金である。

[0013]

【発明の実施の形態】本発明者は、Sbを11質量%以 上含むSn−Sb系はんだ合金(固相融点:246℃) にNi、Geを添加することにより、Sn-Sb系はん だ合金の濡れ性、耐熱性および熱疲労特性を向上させて 接合信頼性を確保できることを見いだした。

【0014】本発明の電子部品接合用はんだ合金におい て、Sb含有量は11~15質量%である。Sb含有量

3

46℃未満となり、電子部品内部の接合性が損なわれる 危険がある。一方、Sb含有量が15質量%を超える と、液相線温度と固相線温度の差が50℃以上となるため、溶融状態のはんだ合金の温度が液相線温度から固相 線温度になるまでに晶出するSn-Sb化合物結晶粒が 粗大化する。そのため、前述したように、はんだ合金に クラックが発生しやすくなる。

【0016】また、Geを添加することによりGe結晶 粒が微細に析出するため、Sn-Sb化合物結晶粒の粗 大化を抑制することができる。その他に、GeはSnよ り酸化されやすいため、はんだ合金にGeを添加するこ とにより、Snの酸化による濡れ性の低下も抑制でき る。

【0017】NiおよびGeのうちの少なくとも1種の含有量は、0.01~1質量%である。上記少なくとも1種が0.01質量%未満では、該少なくとも1種の添加効果がない。一方、上記少なくとも1種が1質量%より多くなると、Sn-Ni化合物やGe結晶粒の偏折が*

*多くなる。

[0018]

【0019】 [従来例1] 表1に示すPb、Snの組成を有するPb-Sn系はんだ合金を用いた以外は実施例1と同様にして、耐熱性試験を実施した。

【0020】以上の結果を表1に示す。表中、例えば0/5は、5個の接合部のうちクラックの発生したものが零であることを示す。

【0021】表1から次のことが分かる。

【0022】(1)実施例1~18(Sn-Sb系)および従来例1(Pb-Sn系)では、230~270℃ 20 のいずれの温度でも、5個中いずれの接合部にも、クラックは入らなかった。

【0023】(2)比較例 $1\sim5$ では、250℃以上または260℃以上の温度で、5個中 $1\sim3$ 個の接合部にクラックが入った。因みに、比較例3の接合部の組織はSn-Sb 化合物結晶粒が粗大化していた。また、比較例5の接合部の組織はSn-Ni 化合物やGe 結晶粒の偏析が発生していた。

[0024]

【表1】

	はんだ組成 (質量%)				はんだクラック発生数				
					保持温度(℃)				
	Sb	Ni	Ge	Sn	230	240	250	260	270
東実東実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実	111335551135551355	0.01 1 0.01 0.5 1 - - - 0.007 0.5 0.005 0.005	- - - - 0.01 1 0.01 0.5 1 0.05 0.5 0.03 0.5	残残残残残残残残残残残残残残残残残残	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	55 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5
比較例 1 比較例 2 比較例 3 比較例 4 比較例 5	11 15 17 17 17	- 1 - 1	- - 1 1	残残残残残	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	0/5 0/5 0/5 0/5 0/5	1/5 2/5 1/5 0/5 0/5	1/5 2/5 0/5 1/5 1/5	2/5 3/5 1/5 1/5 2/5
従来例 1	Sn:5、残部:Pb				0/5	0/5	0/5	0/5	0/5

(4)

特開2002-321084

性・耐熱性・熱疲労特性の改善されたSn-Sb系はん だ合金を提供することができ、従って環境汚染がなく、

しかも高い信頼性で、電子部品の内部接合を行うことが できる。